

КП737А-Г

**МОЩНЫЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ N-КАНАЛЬНЫЙ
МОП ТРАНЗИСТОР**

АДБК 432140.637 ТУ

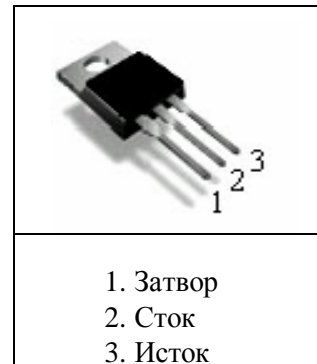
КРЕМНИЕВЫЕ ЭПИТАКСИАЛЬНО-ПЛАНАРНЫЕ ПОЛЕВЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ С ИЗОЛИРОВАННЫМ ЗАТВОРОМ, ОБОГАЩЕНИЕМ N-КАНАЛА И ВСТРОЕННЫМ ОБРАТНОСМЕЩЕННЫМ ДИОДОМ. ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ИСТОЧНИКАХ ВТОРИЧНОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ С БЕСТРАНСФОРМАТОРНЫМ ВХОДОМ, РЕГУЛЯТОРАХ, СТАБИЛИЗАТОРАХ И ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯХ С НЕПРЕРЫВНЫМ ИМПУЛЬСНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ, СХЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯМИ И ДРУГОЙ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЕ.

* Зарубежный аналог - **IRF630, 634, 635, IRL630**

* Изготавливается в корпусе КТ-28 (ТО-220).

ПРЕДЕЛЬНО-ДОПУСТИМЫЕ РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Параметры	Обозначение	Ед. изм.	Предельные значения			
			А	Б	В	Г
Напряжение сток-исток	Uси max	В	200	250	250	200
Напряжение затвор-исток	Uзи max	В	±20	±20	±20	±10
Постоянный ток стока	Iс max	А	9	8	6.5	9
Импульсный ток стока	Iс и max	А	36	32	26	36
Рассеиваемая мощность	Pmax	Вт	74	74	74	74
Прямой ток диода	Iпр. max	А	9	8	6.5	9
Температура перехода	Tпер	°С	150	150	150	150



ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (Токр.ср.=25°С)

Параметры		Обозначение	Ед. измерения	Режимы измерения	Min	Max
Пороговое напряжение	КП737А-В КП737Г	Uзи пор	В	Iс=0.25мА, Uзи=Uси	2.0	4.0
					1.0	2.0
Ток стока	КП737А КП737Б КП737В КП737Г	Iс	А	ti ≤300мкс. Q ≥50 Uси=4В, Uзи=10В Uси=4.8В, Uзи=10В Uси=4.8В, Uзи=5В	9.0	
					8.1	
					6.5	
					9.0	
Сопротивление сток-исток в открытом состоянии	КП737А КП737Б КП737В КП737Г	Rси отк	Ом	ti ≤300мкс. Q ≥50 Iс=5.4А, Uзи=10В Iс=5.1А, Uзи=10В Iс=4.1А, Uзи=10В Iс=5.4А, Uзи=5В		0.4
						0.45
						0.68
						0.4
Остаточный ток стока		Iс ост	мкА	Uси=Uси max, Uзи=0		250
Ток утечки затвора		Iз ут	нА	Uси=0, Uзи=Uзи max	-100	+100
Крутизна ВАХ	КП737А КП737Б КП737В КП737Г	S	А/В	ti ≤300мкс. Q ≥50 Uси=25В, Iс=5.4А Uси=25В, Iс=5.1А Uси=25В, Iс=4.1А Uси=25В, Iс=5.4А	3.8	
					3.6	
					2.9	
					5.0	
Прямое напряжение диода		Uпр	В	Iс=Iс max, Uзи=0		2.0
Время вкл./выкл.	КП737А КП737Б,В КП737Г	* твкл/ твыкл	нс	ti ≤300мкс. Q ≥50, Uси=25В, Iс=5.1А, Rг=12 Ом, Rси=16 Ом		41/59
						30/62
						104/70
Тепл.сопротивл. переход-корпус		* Rt п-к	°С/Вт			1.7
Входная емкость	КП737А-В КП737Г	* C11и	пФ	Uзи=0, Uси=25В, f=1МГц	1300	
					1800	
Выходная емкость	КП737А-В КП737Г	* C22и	пФ	Uзи=0, Uси=25В, f=1МГц	360	
					700	
Проходная емкость	КП737А-В КП737Г	* C12и	пФ	Uзи=0, Uси=25В, f=1МГц	120	
					250	

* Справочные параметры

Диапазон рабочей температуры от -55 до +125°С

220108, г.Минск, ул. Корженевского,16 УП "Завод Транзистор"

Отдел маркетинга: т/ф (10-37517) 212-59-32

E-mail: market@transistor.com.by <http://www.transistor.by>